

性能特点：

- 频带：7GHz~13GHz
- 插入损耗：1.2dB@13GHz
- 隔离度：34dB@13GHz
- 开态输入回波损耗：18dB
- 开态输出回波损耗：18dB
- 关态输出回波损耗：19dB
- 芯片尺寸：1.7mm×1.3mm×0.1mm

产品简介：

HH-SW20713M 是一款 GaAs 匹配式单刀双掷开关芯片，该芯片输入输出均加有隔直电容，在 7GHz~13GHz 频率范围内插损小于 1.2dB，隔离度大于 34dB。

电参数：(TA=25°C)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	7GHz-13GHz			GHz
插入损耗	-	1.2	-	dB
隔离度	-	34	-	dB
输入回波损耗 (ON)	-	18	-	dB
输出回波损耗 (ON)	-	18	-	dB
输出回波损耗 (OFF)	-	19	-	dB

使用限制参数：

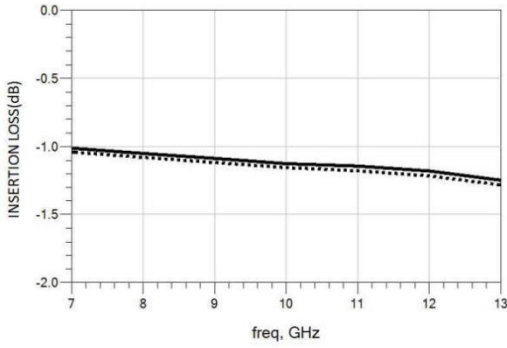
最大输入功率	27dBm
存储温度	-65°C-150°C
使用温度	-55°C-85°C

真值表：

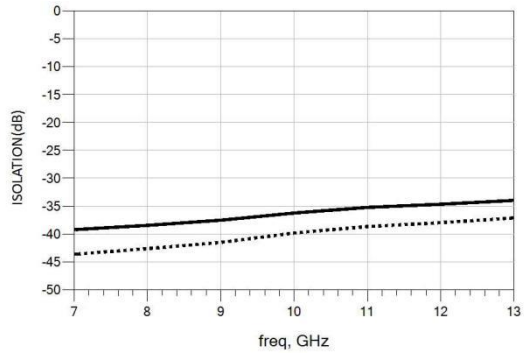
V1	REC to RF1	REC to RF2
0V	on	off
5V	off	on

典型曲线：

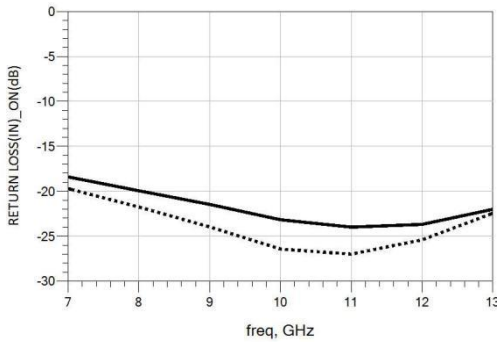
插入损耗



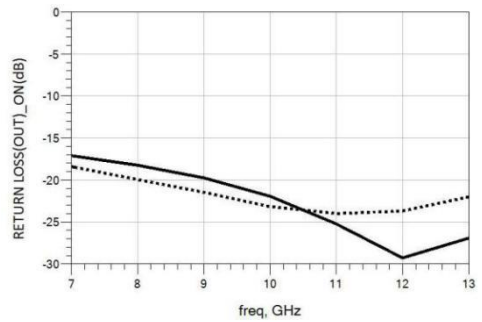
隔离度



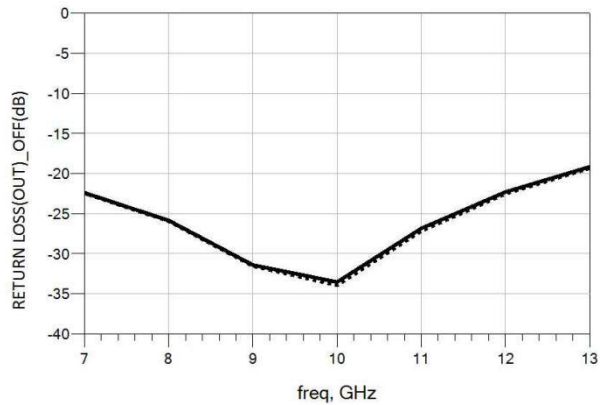
开态输入回波损耗



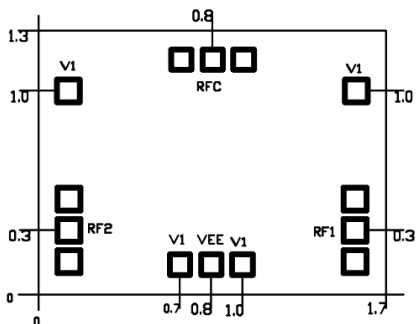
开态输出回波损耗



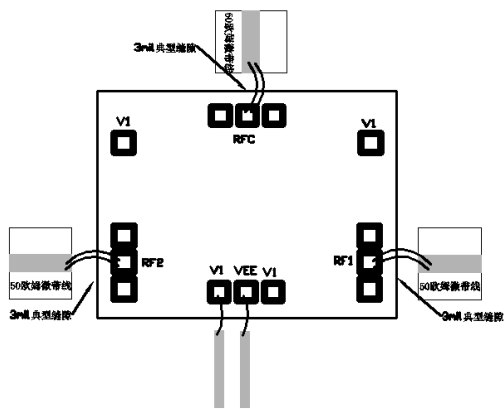
关态输出回波损耗



尺寸图：(单位 mm)



建议装配图：



使用说明：

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度 300um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）